

Fachprüfung

Elektronik II

19. März 2025

Name:	Vorname:	
MatrNr.:	Fachrichtung:	

Α	B1	B2	B3	Gesamt
/32	/17	/11	/10	/70

Als Unterlagen für die Prüfung ist ein beidseitig handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt zugelassen. Alternativ kann auch ein einseitig bedrucktes DIN-A4-Blatt verwendet werden. Die Kombination aus einem teils handschriftlichen und teils bedruckten Blatt ist nicht zulässig und wird unmittelbar als Täuschungsversuch gewertet. In jedem Fall ist das DIN-A4-Blatt mit Name und Matrikelnummer zu versehen. Mobiltelefone sind nicht zugelassen.



Teil A: Kurzfragen

Bitte markieren Sie alle richtigen Aussagen.

Aufgabe A1

1.1 Logik Gatter (4 Punkte)

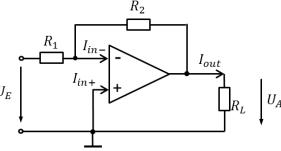
- □ Ein CMOS-Inverter erreicht im Gegensatz zum n-MOS Inverter einen minimalen logischen Ausgangspegel von 0 Volt.
- □ Ein NOR-Gatter in CMOS-Logik benötigt einen zusätzlichen Inverter am Ausgang, um die Logikpegel korrekt darzustellen.
- □ Die dynamische Verlustleistung eines CMOS-Gatters ist proportional zur Schaltfrequenz und der Lastkapazität.
- □ In Analogschaltungen werden MOS-Transistoren bevorzugt im Sättigungsbereich betrieben, um eine konstante Verstärkung sicherzustellen.

1.2. Invertierender Verstärker (4 Punkte)

- Die Spannung zwischen den Eingängen des Operationsverstärkers ist immer gleich der Betriebsspannung.
- □ Eine Erhöhung des Feedback-Widerstandes R2 vergrößert betragsmäßig die Verstärkung
- \Box Der Eingangswiderstand der Schaltung entspricht dem Rückkopplungswiderstand R_2 .
- □ Ein Kondensator parallel zum Rückkopplungswiderstand stabilisiert die Temperaturabhängigkeit des Verstärkers.

1.3 Bandbreite eines gegengekoppelten OPs (4 Punkte)

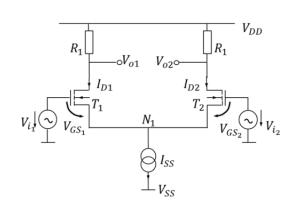
- □ Die Bandbreite eines gegengekoppelten Spannungsverstärkers ist die Frequenz, bei der die Verstärkung um 3 dB gegenüber ihrem maximalen Wert abgefallen ist.
- □ Die Stärke der Rückkopplung eines gegengekoppelten Verstärkers hat keinen Einfluss auf die Bandbreite.
- □ Das sog. Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (*gain-bandwidth product GBW*) ist die maximale Verstärkung geteilt durch die Bandbreite bei dieser Verstärkung.
- □ Die Amplitude und Phase steigen beide mit zunehmender Frequenz an





1.4 Großsignalverhalten der Differenzstufe **(4 Punkte)**

- □ Wenn ein Transistor sperrt und der Strom I_{ss} komplett durch den anderen Transistor fließt, ist die obere Grenze für die Eingangsspannung erreicht
- Der Aussteuerbereich wird durch das W/L-Verhältnis der Transistoren eingestellt
- \Box Der Aussteuerbereich ist durch den Strom I_{SS} einstellbar
- \Box Ein kleiner Strom I_{SS} führt zu größerer Verlustleistung

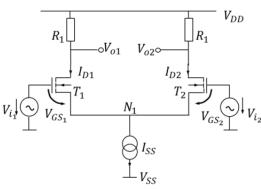


1.5 Kleinsignalverhalten von Transistoren (4 Punkte)

- □ Der Parameter g_m ist über das $\frac{w}{L}$ -Verhältnis einstellbar.
- \Box Der Widerstand r_{DS} modelliert den Substrateffekt im ESB
- \Box Die Kanallängenmodulation führt zu einem kleineren u_{out} und reduziert somit die Verstärkung.
- $G \circ U_{GS} \circ U_{GS} \circ U_{SB} \circ U_{SB}$
- \Box Die Stromquelle $g_{mb} \cdot u_{SB}$ modelliert die Kanallängenmodulation, es gilt $g_{mb} \gg 0$.

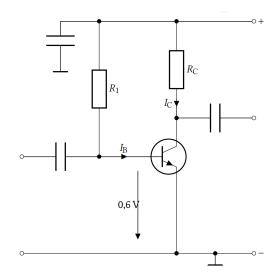
1.6 Differenzstufe (4 Punkte)

- Schaltungstechnisch ist es sinnvoll die Bulk-Anschlüsse mit Source zu verbinden.
- ☐ Technologisch ist es vorteilhaft die Bulk-Anschlüsse mit Masse zu verbinden.
- Sowohl schaltungs- und technologietechnisch ist es sinnvoll die Bulk-Anschlüsse mit den jeweiligen Drain-Anschlüssen zu verbinden.
- □ Die Bulk-Anschlüsse müssen mit den jeweiligen Gate-Anschlüssen verbunden werden, da ansonsten die Transistoren immer sperren.



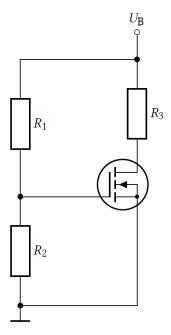
1.7 Die Betriebsspannung beträgt 5 V, der Kollektorstrom soll 4mA betragen, die Gleichstromverstärkung des Transistors beträgt 200. Berechnen Sie den Vorwiederstand R₁ (4 Punkte)

- \Box ca. 200k Ω
- □ ca. 715kΩ
- \Box ca. $68k\Omega$
- \Box ca. 2,3k Ω



1.8 Wie groß muss R_2 gewählt werden, damit sich eine Spannung von 2,8V zwischen Gate und Source einstellt? U_B =44V, R_1 =10k Ω , R_3 =2,2k Ω (4 Punkte)

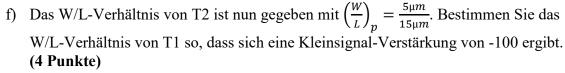
- \Box ca. 680Ω
- □ ca. 1405Ω
- \Box ca. 68Ω
- \Box ca. 820Ω

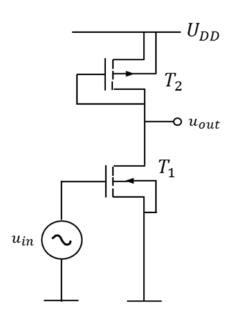


Teil B: Aufgaben

Aufgabe B1 p-Kanal-Transistor als Lastelement

- a) Stellen Sie für die nebenstehende Schaltung das Kleinsignalersatzschaltbild (ESB) auf.(2 Punkte)
- b) Bestimmen Sie r_{out} unter der Annahme, dass gilt $g_m \gg \frac{1}{r_{DS}}$. (2 Punkte)
- c) Bestimmen Sie die Kleinsignal-Verstärkung *A.* (3 Punkte)
- d) Welchen Wert nimmt die Kleinsignal-Verstärkung an, wenn die beiden Transistoren T1 und T2 über ein identisches W/L-Verhältnis verfügen. Nehmen Sie hierbei an, dass gilt $\beta_{0n} \approx 3\beta_{0p}$. (4 Punkte)
- e) Wodurch ist die Annahme $\beta_{0n} \approx 3\beta_{0p}$ zu begründen? (2 Punkte)



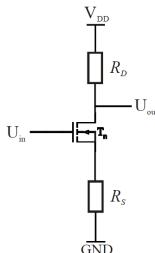




Aufgabe B2 Analoge Schaltung

Geben sei folgende Schaltung:

$$V_{DD} = 5V$$
 $U_{Th0n} = 0.8V$
 $\beta_{0n} = \frac{100\mu A}{V^2}$
 $\lambda_n = 0.1V^{-1}$
 $R_S = 35k\Omega$
 $R_D = 100k\Omega$



a) Dimensionieren Sie den Transistor so dass der Arbeitspunkt ($U_{in}=2,5V,\,U_{out}=2,5V$) eingestellt wird. Welche Spannung fällt über dem Widerstand R_S ab? (die Kanallängenmodulation λ

kann bei dieser Dimensionierung vernachlässigt werden) (3 Punkte)

- b) Skizzieren Sie das Kleinsignal-ESB für die Schaltung. (Die Kapazitäten sind nicht zu berücksichtigen) (3 Punkte)
- c) Berechnen Sie die Kleinsignalparameter des Transistors (g_m, g_{DS}) . (2 Punkte)
- d) Berechnen Sie den Wert der Verstärkung der Schaltung. (3 Punkte)

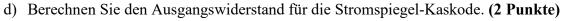
Name:



Aufgabe B3

Stromspiegel mit Gegenkopplung

- a) Stellen Sie das
 Kleinsignalersatzschaltbild (ESB) für die nebenstehende Schaltung auf.
 (2 Punkte)
- b) Das Gatepotential U_{GG} des Transistor T1 kann als konstant angesehen und damit im ESB auf Masse gelegt werden. Ermittelten Sie den Ausgangswiderstand der Schaltung. (2 Punkte)
- c) Ersetzen Sie den Widerstand R in der nebenstehenden Schaltung so durch einen Transistor, dass eine Stromspiegel-Kaskode entsteht. (2 Punkte)



e) Bestimmen Sie die minimale Ausgangsspannung U_{out} der Stromspiegel-Kaskode. (2 Punkte)

